# $(SiC)C_f/Si_3N_4$ 复合陶瓷的制备及性能

肖伟玲<sup>1,2</sup> 肖鹏<sup>1</sup> 周伟<sup>1</sup> 罗衡<sup>1</sup> 李杨<sup>1</sup>

(1 中南大学粉末冶金研究院,长沙 410083)

(2 航天科工武汉磁电有限责任公司,武汉 430050)

**文 摘** 采用 CVD 法制备了 SiC 涂层包覆短碳纤维,并通过凝胶注模成型工艺制备了(SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复 合陶瓷,探讨了烧结温度对复合陶瓷中(SiC) C<sub>f</sub> 形貌的影响。同时研究了(SiC) C<sub>f</sub> 的含量对复合陶瓷力学以及 介电性能的影响,当(SiC) C<sub>f</sub> 含量达到 10wt% 时,样品的抗弯强度比纯 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 陶瓷降低了 112 MPa,但断裂韧性 显著提高,增加了 11.5 MPa·m<sup>1/2</sup>,介电常数实部和虚部达到最大,介电实部约为 15~18,虚部约为 6~8;反射 衰减随(SiC) C<sub>f</sub> 的含量和厚度的增加而向低频移动。

关键词 SiC,  $C_f$ , Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, 力学性能, 介电性能

中图分类号:TB3

DOI:10.3969/j.issn.1007-2330.2015.03.008

## Preparation and Properties for (SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub> N<sub>4</sub> Composite

XIAO Weiling<sup>1,2</sup> XIAO Peng<sup>1</sup> ZHOU Wei<sup>1</sup> LUO Heng<sup>1</sup> LI Yang<sup>1</sup>

(1 State Key Laboratory for Powder Metallurgy, Central South University, Changsha 410083)

(2 Wuhan Electromagnetism Ltd. Company of China Aerospace Science and Industry Corporation, Wuhan 430050)

**Abstract** SiC coating modified  $C_f$  by CVD, then fabricated  $(SiC)C_f/Si_3N_4$  composite by gelcasting. The effect of  $(SiC)C_f$  content toward the mechanical and absorbing properties of the composite were investigated. The flexure strength of  $(SiC)C_f/Si_3N_4$  composites reduced 112 MPa compare with  $Si_3N_4$  ceramic and the fracture toughness increase 11.5 MPa·m<sup>1/2</sup> when the  $(SiC)C_f$  content is 10wt%, meanwhile both the real  $(\varepsilon')$  and imaginary  $(\varepsilon'')$  permittivity of  $(SiC)C_f/Si_3N_4$  composite ceramics reached maximum, the dielectric constant  $\varepsilon'$  is about 15 to 18 and  $\varepsilon''$  is about 6 to 8; the reflectivity of the composites moved to a lower frequency with the  $(SiC)C_f$  content and thickness increased.

Key words SiC, C<sub>f</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Mechanical property, Dielectric property

## 0 引言

随着我国新一代装备的快速发展,对其隐身性能 提出了越来越高的要求,某些装备的特殊部位工作温 度超过1000℃,急需发展高温结构吸波材料<sup>[1-6]</sup>。 高温结构吸波材料具有承载和吸波的双重功能,通过 调整各组分的组成对材料的力学和吸波性能有较强 的可设计性<sup>[7-9]</sup>。

氮化硅(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)基陶瓷具有较低的介电常数,它 的分解温度为1900<sup>°</sup>C,抗高温、抗烧蚀性能好,用于 航天飞行器方面,能在6~7马赫飞行条件下抗热 震<sup>[10-12]</sup>。由于其良好的绝缘性,因此作为透波材料 被广泛应用<sup>[13-15]</sup>。 短碳纤维(C<sub>f</sub>)在 400℃时发生氧化,有着较高的 拉伸强度<sup>[16-17]</sup>,但在陶瓷中,由于碳纤维与基体界面 间的结合状态及氧化等方面的原因,碳纤维所起的补 强作用并不显著。有研究证明,采用表面包覆过渡层 的碳纤维补强陶瓷材料,取得了显著的效果<sup>[18]</sup>。同时 短碳纤维电阻率较低(10<sup>-6</sup> Ω·cm 以下),相互搭接的 短碳纤维易形成导电网络,引起电磁波的强反 射<sup>[19-20]</sup>。采用 CVD 法在碳纤维表面沉积一层 SiC 涂 层,既能阻止短碳纤维之间相互搭接引起电磁波反射, 又能防止短碳纤维和氮化硅基体发生反应,同时对于 复合陶瓷的力学性能有很大影响。

本文通过 CVD 在碳纤维表面制备 SiC/C 复合涂

收稿日期:2015-03-31

基金项目:973 计划项目(2011CB605804)

作者简介:肖伟玲,1983年出生,博士研究生,主要从事高温复合陶瓷研究。E-mail:11100304@qq.com

层,然后以  $Al_2O_3$  和  $Y_2O_3$  为烧结助剂,采用凝胶注模 成型工艺制备(SiC)  $C_{f}$ /Si<sub>3</sub> $N_4$  复合陶瓷,分析了烧结 温度对复合陶瓷显微结构的影响,并研究了短切碳纤 维的含量对复合材料力学及介电性能的影响。

#### 1 实验

#### 1.1 原材料

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>,北京紫光方大高技术陶瓷有限公司(α相含量约为>93%,平均粒径为0.5 μm 左右);T700, 12K碳纤维,日本东丽公司;添加剂Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>均 为常州卓群纳米新材料有限公司生产;丙烯酰胺 (AM)和N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBAM)均为国药 集团化学试剂有限公司生产。

#### 1.2 仪器设备

场发射扫描电子显微镜,Nova Nano SEM 230;万 能材料试验机,美国 Instron, Instron 336;矢量网络分 析仪,美国 Agilent, N5230A。



(a) 碳纤维表面热解炭和 SiC 涂层

### 1.3 性能测试

弯曲强度测试参照 ISO 14704—2000;断裂韧性 测试参照 ISO 23146—2012;利用相对复介电常数和 复磁导率计算并画出了反射损失曲线,计算过程根据 传输线理论进行<sup>[21]</sup>,公式如下:

$$R = 20 \lg \left| \frac{Z_{\rm in} - Z_0}{Z_{\rm in} + Z_0} \right|$$
(1)

$$Z_{\rm in} = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_{\rm r}}{\varepsilon_{\rm r}}} \tanh\left[j\frac{2\pi fd}{c}\sqrt{\mu_{\rm r}\varepsilon_{\rm r}}\right]$$
(2)

#### 1.4 实验方法

## 1.4.1 (SiC)C<sub>f</sub>的制备

以丙烯为炭源,采用 CVD 在长碳纤维表面制备 一层热解炭作为过渡层,然后以三氯甲基硅烷(MTS) 为原料再沉积 SiC 涂层对其进行包覆(图1),表层 SiC 涂层呈致密的颗粒状覆盖在碳纤维表面。将改 性后的长纤维剪成 2 mm 左右备用。



(b) SiC 涂层放大后的 SEM 图

图 1 短碳纤维表面沉积 SiC 和热解炭涂层的 SEM 图

Fig. 1 SEM micrographs and high magnification of SiC/C coating modified  $C_{\rm f}$ 

## 1.4.2 (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>复合陶瓷的制备

按一定配比将 AM、MBAM 和分散剂溶解于水 中,配制成预混液,加入 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 粉球磨 2 h,然后加入 (SiC)C<sub>f</sub> 及聚丙烯酰胺(APAM)球磨 10 min,取出后 抽真空 10 min,加入过硫酸铵搅拌均匀。注模后在 60~80℃固化 1 h,固化后的生坯在无水乙醇中干燥



12 h,然后在 N<sub>2</sub> 气氛保护下 600℃ 排胶并升温至 1 500℃(1 600℃)保温 1.5 h,得到烧结陶瓷。

2 结果与讨论

## 2.1 (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的微观结构

图 2 为在 N<sub>2</sub> 气氛中,碳纤维表面没有改性时与 Si<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合制备复合陶瓷的形貌。



(a) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的形貌
(b) 放大后的 SEM 图
图 2 短碳纤维/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的形貌及短碳纤维放大后的 SEM 图(1 500℃)
Fig. 2 SEM of C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites and high magnification of C<sub>f</sub> at 1 500℃
http://www.yhclgy.com
2015 年 第 3 期

宇航材料工艺

— 35 —

碳纤维在制备过程中有一部分未被分散开,成束 状,在1500℃时并未和Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub>基体发生反应。从图3 可以看出,没有改性的碳纤维在烧结后表面形成大量 孔洞,且基体也呈疏松状态。这主要是因为 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 和



碳纤维发生如下反应:

挥发,从而产生脱落<sup>[22]</sup>:

Si<sub>2</sub>

$$N_4 + 3C = 3SiC + 2N_2$$
 (3)

生成的 N, 通过扩散到达纤维与基体的界面。随温 度的升高,扩散的气体导致界面结构变得更加疏松。



(a) Si<sub>a</sub>N<sub>4</sub>复合陶瓷的形貌 放大后的 SEM 图 (b) 图 3 短碳纤维/Si<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的形貌及短碳纤维放大后的 SEM 图(1600℃)

Fig. 3 SEM of C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites and high magnification of C<sub>f</sub> at 1 600°C

从图4可以看出,(SiC)碳纤维束分散在陶瓷基 体中,且陶瓷基体结构致密,从图4(b)可以看出,SiC 涂层有少量脱落,这可能是因为 SiC 在高温下具有较 高的蒸气压,而 CVD SiC 的晶粒极为细小,再加之晶



格畸变大,更增加了 SiC 的活性,使其以气体的方式

SiC(s) = SiC(v)

(4)

(a) (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷形貌 (b) 放大后的 SEM 图 图 4 (SiC)C<sub>t</sub>/Si<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的形貌及(SiC)C<sub>t</sub> 放大后的 SEM 图(1 500℃) Fig. 4 SEM of (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites and high magnification of (SiC)C<sub>f</sub> at 1 500°C 图 5 中,(SiC)C<sub>f</sub>在1 600℃由于2 层界面层的 保护,并未出现明显损伤。



(a)

mag 🔲 HFW dwell det spot (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>复合陶瓷形貌 放大后的 SEM 图 (b) 图 5 (SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的形貌和放大后的 SEM 图(1600℃) Fig. 5 SEM of (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites and high magnification of (SiC)C<sub>f</sub> at 1 600°C 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com

2015年 第3期

图中可见 SiC 和热解炭涂层基本剥落,这可能是 氮化硅分解产生的 N<sub>2</sub> 和 SiC 涂层发生反应,进而热 解炭在高温下分解脱落,因此可知高于此烧结温度, (SiC)C<sub>t</sub>由于涂层脱落会被高温腐蚀。

以上分析可以得知,短碳纤维和 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 在 1 500℃时没有发生明显的反应,当温度达到 1 600℃ 时,纤维发生反应已经失去了本身的特征;而经过 SiC 改性后的碳纤维在 1 500℃时,SiC 涂层和碳纤维 同时保持完整,当温度达到 1 600℃时,SiC 涂层部分 脱落,但是碳纤维依然保持形态完整。

## 2.2 (SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的力学性能

从图 6 可以看出,随着(SiC)  $C_r$ 含量的增多,试 样的弯曲强度减小,但断裂韧性显著增大。当(SiC)  $C_r$ 含量达到 10wt%时,样品的弯曲强度比纯 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 陶 瓷降低了 112 MPa,但断裂韧性显著提高,增加了 11.5 MPa·m<sup>1/2</sup>。原因是加入的碳纤维使材料的密度 降低、孔隙率增加,从而使材料的强度降低。对于碳 纤维增韧 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>来说,通过基体扩展进入纤维束的裂 纹将首先遭遇纤维-基体界面。当外加载荷提供的 能量超过裂纹扩展所需能量,基体迅速发生开裂,之 后裂纹传播至纤维束中。图 7 为(SiC)  $C_r/Si_3N_4$  复合 陶瓷断裂时的微观形貌图。



Fig. 6 Flexure strength and fracture toughness of (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites



图 7 (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷断裂形貌 Fig. 7 Fracture surface of (SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2015 年 第 3 期 可以明显的看到有纤维束的存在,碳纤维表面光 滑无损伤,说明在纤维上制备 C/SiC 双涂层可有效地 保护碳纤维,防止高温下碳纤维与 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 发生反应。 同时在断口处可以观察到纤维长短不一,有明显的纤 维拔出,纤维、涂层及基体之间结合适当,保证了纤维 的增韧作用。复合陶瓷断面上亦可观察到少量的涂 层脱落,裂纹绕过纤维扩展也说明纤维和基体之间存 在断裂前的脱粘<sup>[23]</sup>。

## 2.3 (SiC) C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷的介电性能

从图 8 可以看出纯  $Si_3N_4$  陶瓷虚部接近 0,对电 磁波基本没有损耗,而复合陶瓷介电常数实部和虚部 均随(SiC)  $C_f$  含量的增加而提高,当(SiC)  $C_f$  质量分 数为 10wt%时,介电常数实部和虚部达到最大,分别 为  $15 \sim 18 \ \pi 6 \sim 8_{\odot}$ 



图 8 (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 复合陶瓷(1 500℃)的介电性能 Fig. 8 Permittivity of (SiC)C<sub>f</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites at 1 500℃

为了评估(SiC)  $C_f$ /Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>的介电性能,计算了厚度为1.5和3mm时复合陶瓷的反射率,结果如图9所示,可以看出当(SiC)  $C_f$ 质量分数为10%时,吸波效果较好,厚度为1.5mm时,吸波频率大于10GHz时,反射率均小于-6dB。当厚度为3mm时,反射衰减向低频移动,吸波频率 < -8dB时,反射率达到-6dB。因此,适当增加材料的厚度,使材料在低频波段得到较好的衰减,有利于电磁波在低频段的吸收。



#### 3 结论

采用 CVD 法在短碳纤维表面制备了 SiC 和热解 炭涂层,并通过凝胶注模成型工艺将(SiC)C。和 Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub> 陶瓷复合制备耐高温陶瓷。结果表明,短碳纤 维和 Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub> 陶瓷在1 500℃ 时没有发生明显的反应. 当温度达到1600℃时,纤维发生反应已经失去了本 身的特征:而经 SiC 涂层改性后的短碳纤维在1 500℃时,SiC 涂层和碳纤维同时保持完整,当温度达 到1600℃时,SiC涂层部分脱落,但是碳纤维依然保 持形态完整。在复合陶瓷中,随着(SiC)C,含量的增 多,试样的弯曲强度减小,但断裂韧性显著增大。当 (SiC)C,含量达到10wt%时,样品的弯曲强度比纯 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 陶瓷降低了 112 MPa,但断裂韧性显著提高,增 加了11.5 MPa·m<sup>1/2</sup>.断裂机制为纤维拔出和裂纹绕 讨界面扩展。复合陶瓷介电常数实部和虚部均随 (SiC)C<sub>c</sub>含量的增加而有所提高,当(SiC)C<sub>c</sub>质量分 数为10%时,介电常数实部和虚部达到最大,介电实 部约为15~18,虚部约为6~8。反射率计算可以得 出,反射衰减随(SiC)C,含量的增加和厚度的增加而 向低频移动。

#### 参考文献

[1] Qing Y,Zhou W,Luo F, et al. Microwave electromagnetic properties of carbonyl iron particles and Si/C/N nano-powder filled epoxy-silicone coating [J]. Physica B: Condensed Matter, 2010, 405:1181-1184

[2] 周晓群. 反隐身雷达技术及其对抗[J]. 舰船电子工程, 2006(1):11-18

[3] 罗发,周万城,焦桓,等.高温吸波材料研究现状 [J]. 宇航材料工艺,2002,32(1):8-11

[4] 王自容, 余大斌. 雷达隐身技术概述[J]. 上海航 天,1999(3):52-56

[5] 刘献明, 付绍云, 张以河,等. 雷达隐身复合材料的进展[J]. 材料导报, 2004,18(5):8-11

[6] 宋永才, 李斌. 由有机-无机混杂先驱体制备 SiC 纳 米微粉[J]. 材料科学与工程学报, 2004,22(3):341

[7] Luo Heng, Xiao Peng, Huang Long, et al. Dielectric properties of  $C_f\mbox{-}Si_3N_4$  sandwich composites prepared by gelcast-ing[J]. Ceramics International, 2014,40(6) :8253-8259

[8] Song Weili, Cao Maosheng, Hou Zhiling, et al. Hightemperature microwave absorption and evolutionary behavior of multiwalled carbon nanotube nanocomposite[J]. Scripta Materialia, 2009,61(2):201-204

[9] Luo F,Zhu D,Zhou W. A two-layer dielectric absorber covering a wide frequency range [J]. Ceramics International,

2007,33:197-200

[10] 张伟儒, 王重海, 刘建, 等. 高性能透波 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-BN 基陶瓷复合材料的研究[J], 硅酸盐通报, 2003, 3·3-6

[11] 高晓菊, 王红洁. 高温微波功能复合材料研究进展 [J]. 硅酸盐通报, 2007(5):975-979

[12] 齐共金, 张长瑞, 胡海峰, 等. 陶瓷基复合材料天 线罩制备工艺进展[J]. 硅酸盐学报, 2005, 33(5); 632-638

 $[\,13\,]$  Zhang Li L, Yin X. , et al. Effect of chemical vapor infiltration of SiC on the mechanical and electromagnetic properties of  $\rm Si_3N_4-SiC$  ceramic[J]. Scr. Mater. , 2010,63:657–660

[14] 李瑞,张长瑞,李斌,等. 氮化硅高温透波材料的研 究现状和展望[J]. 宇航材料工艺, 2011,41(6):4-6

[15] Li X M, Yin X W, Zhang L T, et al. Mechanical and dielectric properties of porous  $Si_3N_4$  –  $SiO_2$  composite ceramics [J]. Materials Science Engineering A, 2009,500; 63–69

[16] Walter Krenkel. Carbon fiber reinforced CMC for highperformance structures[J]. Int. J Appl. Ceram. Technol. ,2004,1 (2):188-200

[17] JU C P, Wang C K, Cheng H Y, et al. Process and wear behavior of monolithic SiC and short carbon fiber-SiC matrix composite[J]. J Mate. Sci., 2000,35: 4477-4 484

[18] Kohyama A, Kotani M, Katoh Y, et al. High-Performance SiC/SiC composites by improved PIP processing with new precursor polymers [J]. Journal of Nuclear Materials, 2000, 283-287 (part 1):565-569

[19] Zhou Wei, Xiao Peng, Li Yang, et al. Dielectric properties of BN modified carbon fibers by dip-coating[J]. Ceramics International, 2013, 39: 6569-6576

[20] Zhou Wei, Xiao Peng, Li Yang. Preparation and study on microwave absorbing materials of boron nitride coated pyrolytic carbon particles [J]. Applied Surface Science, 2012, 258:8455-8459

[21] Sumfleth J, Prehn K, Wichmann M H G, et al. A comparative study of the electrical and mechanical properties of epoxy nanocomposites reinforced by CVD and arc-grown multi-wall carbon nanotubes[J]. Composite Science Technology, 2010, 70:173– 180

[22] 张显, 成来飞, 张立同, 等. 石墨上化学气相沉积 SiC 组织特征与性能[J]. 稀有金属材料与工程, 2007, 36:960 -963

[23] Miller J H, Liaw P K, Landes J D. Influence of fiber coating thickness on fracture behavior of continuous woven nicalon fabric-reinforced silicon-carbide matrix ceramic composites [J]. Materials Science and Engineering A,2001,317(1/2):49-58

(编辑 吴坚)